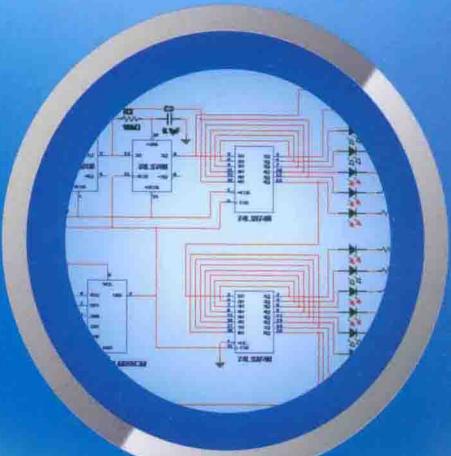


“十二五”普通高等教育电气信息类实验规划教材

# 数字电子技术实验教程

第二版

- 周 敏 主编
- 朱湘临 蒋 彦 副主编
- 高 平 主审



化学工业出版社

“十二五”普通高等教育电气信息类实验规划教材

# 数字电子技术实验教程

第二版

周 敏 主 编

朱湘临 蒋 彦 副主编

高 平 主 审



化学工业出版社

· 北京 ·

本书是数字电子技术的配套实验教程，可作为高等学校电气信息类、电子信息类的本科生实验教程，其他相近专业也可以参考使用。

全书的内容分上、下两篇。上篇是数字电子技术实验部分，在内容的选择上侧重基础实验，以培养学生的基本实验技能。同时辅以少量的综合实验，用来提高学生综合解决问题的能力。下篇是数字电子技术仿真实验部分，目的是使学生能够熟练掌握仿真软件 Multisim 在数字电路中的应用，书中所用的仿真实例均在 Multisim 11 中调试运行过。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

数字电子技术实验教程/周敏主编. —2 版. —北

京：化学工业出版社，2014.1

“十二五”普通高等教育电气信息类实验规划教材

ISBN 978-7-122-19324-7

I. ①数… II. ①周… III. ①数字电路-电子技术-  
实验-高等学校-教材 IV. ①TN79-33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 305331 号

---

责任编辑：郝英华

装帧设计：刘丽华

责任校对：吴 静

---

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 装：三河市延风印装厂

787mm×1092mm 1/16 印张 7 3/4 字数 176 千字 2014 年 3 月北京第 2 版第 1 次印刷

---

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

---

定 价：18.00 元

版权所有 违者必究

本书是为数字电子技术课程编写的配套实验教程。数字电子技术是高等工科院校的重要专业基础课之一，实验则是该课程的一个重要环节。通过这一实践性教学环节，不仅可以巩固和加深对理论知识的理解，更重要的是训练学生的实验技能，培养学生独立思考和勇于创新的精神。

本书的内容分上、下两篇。上篇是数字电子技术实验部分，介绍了数字电路实验的基本知识、基础实验和综合设计性实验。基础实验包括集成逻辑门电路参数的测试、集电极开路门及三态门电路的应用、组合逻辑电路的设计、时序逻辑电路的设计等。实验的要求与理论教学内容一致，每个实验还安排了思考题，进一步拓展学生的思维。综合设计实验包括彩灯循环控制电路设计、多路智力抢答器的设计等。需要学生将所学知识融会贯通，可全面提升学生分析问题、解决问题的能力。下篇是数字电子技术仿真实验部分。考虑到计算机仿真在电子电路的分析与设计中日渐重要，本书引入了常用的仿真工具 Multisim 软件，介绍了 Multisim 11 在数字电子技术中的应用，给出了数字电路的仿真实例，使学生能快速掌握用 Multisim 仿真分析数字电路的一般方法和步骤。

本书由江苏大学周敏担任主编，朱湘临、蒋彦担任副主编。周晓霞、严雪萍、刘叶飞、朱爱国参与了编写工作。高平担任本书的主审，提出了很多宝贵意见，在此表示衷心的感谢。

限于编者的水平，书中难免出现不足之处，恳请各位读者予以批评指正。

编者  
2013年12月

## 上篇 数字电子技术实验

1

### 第1章

#### 实验基础知识

- 1.1 实验目的与意义 / 1
- 1.2 实验要求 / 1
- 1.3 数字集成电路概述 / 2

2

### 第2章

#### 数字电子技术基础实验

- 2.1 实验一 集成逻辑门电路参数的测试 / 7
- 2.2 实验二 集电极开路门及三态门电路的应用 / 12
- 2.3 实验三 门电路及组合逻辑电路的设计 / 19
- 2.4 实验四 全加器及其应用 / 22
- 2.5 实验五 数据选择器及其应用 / 27
- 2.6 实验六 触发器及其应用 / 32
- 2.7 实验七 计数器及其应用 / 37
- 2.8 实验八 移位寄存器及其应用设计 / 44
- 2.9 实验九 集成 555 定时器及其应用 / 48
- 2.10 实验十 A/D 和 D/A 转换器 / 54
- 2.11 实验十一 随机存储器及其应用 / 58

3

### 第3章

#### 数字电子技术综合实验

- 3.1 实验一 彩灯循环控制电路设计 / 63

- 3.2 实验二 数字频率计的设计 / 65  
3.3 实验三 多路智力抢答器设计 / 67

## 下篇 数字电子技术仿真实验

4

### 第 4 章

#### Multisim 在数字电子技术中的应用

- 4.1 逻辑函数的化简及其相互转换 / 69  
4.2 常用数字逻辑器件性能的仿真测试 / 71

5

### 第 5 章

#### Multisim 11 综合仿真实例

- 5.1 8421BCD 码加法器 / 81  
5.2 二十五进制减计数器 / 82  
5.3 流水灯电路 / 83  
5.4 智力竞赛抢答器 / 84  
5.5 程序计数分频器 / 85  
5.6 序列信号产生电路 / 87  
5.7 模拟声响电路 / 88  
5.8 随机灯发生器 / 89

附录 A Multisim 11 的元器件库简介 / 91

附录 B Multisim 11 的虚拟仪器简介 / 98

附录 C YB02-8 电工电子综合实验箱 / 115

### 参考文献

## 第1章 实验基础知识

### 1.1 实验目的与意义

数字电子技术实验是实践性很强的课程，它的任务是使学生获得数字电子技术基本理论和基本实验技能，培养学生分析问题和解决问题的能力，养成认真严谨、实事求是的工作态度，为今后的综合设计奠定扎实的基础。

### 1.2 实验要求

为了保证实验的顺利完成，对学生有如下的要求。

#### (1) 实验前

认真复习有关的理论知识，阅读实验教材，了解实验目的、实验原理及实验内容，预习实验中所用仪器的性能和使用方法，初步估算实验结果并写出预习报告。

#### (2) 实验过程中

- ① 进入实验室要遵守实验室各项规章制度。
- ② 按实验步骤认真接线，合理布局。按操作规程正确使用仪器设备。
- ③ 在实验过程中如果发生问题，或仪器设备发生故障，应该立即切断电源，然后冷静分析问题所在，在指导老师的帮助下解决问题，排除故障。

④ 实验中要认真记录实验数据和结果，实验结束时将实验记录送交指导老师审阅签字。

⑤ 离开实验室时要将实验台整理好，切断所有仪器设备的电源。

### (3) 实验后

根据实验中测得的数据，认真撰写实验报告。实验报告的具体要求如下。

① 实验报告要用规定的实验报告纸书写。

② 实验报告要书写工整、布局合理。

③ 实验内容要齐全，应包括实验目的、实验原理、实验电路、实验所需仪器设备及器件、测试数据、实验结果、问题分析及体会。

## 1.3 数字集成电路概述



### 1.3.1 数字集成电路的分类及特点

数字集成电路诞生于 20 世纪 60 年代，经过几十年的发展，数字集成电路几经更新换代，已经形成了多种系列产品并存发展的局面。数字集成电路分为两大类。第一类是双极型 TTL，一条是沿着 74→74LS→74ALS 系列向低功耗、高速度发展，另一条是沿着 74H→74S→74AS 的高速化发展，还有 ECL 沿着 10K→100K 系列向超高速化发展。第二类属于单极型，即 CMOS 类型为主，沿着 4000A→4000B/4500B→74HC 系列向高速化发展，同时又保持了低功耗的优点。

#### (1) TTL 类型

TTL 集成电路是以双极型晶体管为元件，输入极采用多发射极晶体管形式，开关放大电路也都是由晶体管构成的。在速度和功耗方面，都处于现代数字集成电路的中等水平。

① 74LS 系列。74LS 系列是现代 TTL 类型中的主要应用产品，也是逻辑 IC 的重点产品之一，它的品种丰富，价格低廉，是目前使用较多的主流产品。

② 74S 系列。74S 系列是 TTL 的高速型，它的品种比 74LS 系列少，它的功耗比 74LS 型大得多，但其速度比较快。

③ 74ALS 系列。74ALS 系列集成电路的主要优点是速度快，功耗比 74LS 系列低，是 74LS 系列的后续产品。74ALS 系列的特性和 74LS 系列近似，单价较高，品种也比较少。

④ 74AS 系列。74AS 系列是 74S 系列的后继产品，其速度和功耗都有所改进。

#### (2) CMOS 类型

CMOS 器件是用 MOS-FET 作为开关元件，构成互补型电路，属于单极型 IC。主要产品系列有 4000A-4000B/4500B, 40H, 74HC, 74AC。CMOS 产品的主要特点如下。

① 静态功耗很低。一般中规模集成电路的静态功耗小于 100mW。

② 电源电压范围宽。一般工作电压在 3~18V 之间。

③ 输入阻抗非常高。正常工作时，输入阻抗可达 100MΩ 以上。

- ④ 品种多而齐全。
- ⑤ 扇出能力强。低频工作时，可驱动 50 个以上的 CMOS 器件输入端。
- ⑥ 抗干扰容限大。电压噪声容限可达电源电压的 45%。
- ⑦ CMOS 集成电路的速度比较低。

TTL 产品和 CMOS 产品应用非常广泛，具体性能指标可以查阅 TTL、CMOS 集成电路手册。

### 1.3.2 数字集成电路选择原则

TTL 型和 CMOS 型是常用数字集成电路器件，它们各有特点。TTL 电路的速度高，超高速 TTL 电路的平均传输时间约为 10 ns，中速 TTL 电路的传输时间也有 50 ns。CMOS 电路的速度慢于 TTL 电路的速度，但是 CMOS 电路的功耗低，输出电压幅度可调范围大，抗干扰能力也比 TTL 电路强。TTL 电路的输出电流比 CMOS 电路的大。一般情况下；当要求速度高时，多选用 TTL 器件；当要求低功耗时，多选用 CMOS 器件。集成电路常用的封装形式有 3 种，即双列直插式、扁平式和直立式，通常选用双列直插式。其他则根据特殊需要而选择器件，如表 1-3-1 所示。

表 1-3-1 CMOS、TTL 器件选用原则

器件性能要求			选用器件种类
工作频率 $f / \text{MHz}$	功耗 $P$	其他	
$\leq 5$		使用方便、成本低、耐用	肖特基低功耗 TTL
$\geq 30$			高速 TTL
$\leq 1$	小	输入阻抗高、抗干扰能力强	普通 CMOS
1~30	小	输入阻抗高、抗干扰能力强	高速 CMOS

### 1.3.3 使用 TTL、CMOS 集成电路的注意事项

#### (1) 使用 TTL 电路的注意事项

① TTL 集成电路的标准电源电压为 5V，使用时电源电压不能高于 5.5V。不能将电源与地颠倒错接，否则将会因为电流过大而烧毁器件。

② 电路的各输入端不能直接与高于 5.5V 或低于 -0.5V 的低内阻电源相连，因为低内阻电源能提供较大的电流，从而导致器件过热而损坏。

③ 除三态门和集电极开路的电路外，输出端不允许并联使用。

④ 输出端不允许与电源和地短接，但可以通过电阻与电源相连，提高输出电平。

⑤ 在电源接通时，不要移动或插入集成电路。因为电流的冲击可能造成芯片损坏。

⑥ 多余的输入端最好不要悬空，因为悬空容易受干扰。有时会造成误操作，因此，多余输入端要根据需要处理。如与门、与非门的多余输入端可接到正电源，也可以将多余输入端和使用端并联使用。不用的或门、或非门的输入端可以直接接地或与使用端并联使用。触发器不使用的输入端也不能悬空，应该根据逻辑功能接入电平，输入端连线应该尽量短，这样可以缩短时序电路中时钟信号沿传输线传输的延迟时间。一般不允许触发器的输出端直接

驱动指示灯、电感负载和长线传输，需要时加缓冲器。

## (2) 使用 CMOS 集成电路时的注意事项

CMOS 电路由于输入电阻很高，因此极易接受静电电荷，为了防止静电击穿，生产 CMOS 电路时输入端都加了标准保护电路。但这并不能保证绝对安全，因此，使用 CMOS 电路时必须注意以下内容。

① 存放 CMOS 集成电路时要采用金属屏蔽盒储存或金属纸包装，防止外来感应电压击穿器件。

② 焊接 CMOS 电路时，一般用 20 W 内热式电烙铁，而且电烙铁应该有良好的接地线。禁止在电路接通电时焊接。

③ COMS 电路的输入端不能短路，否则会造成 CMOS 管的损坏。

④ 为了防止输入端保护二极管因正向偏置而引起损坏，输入电压必须处于  $V_{DD}$  与  $V_{SS}$  之间。

⑤ 在调试 COMS 电路时，应该先接通电源，后加入输入信号，即在 CMOS 电路本身没有接通电源的情况下，不允许有信号输入。

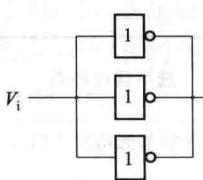
⑥ 多余输入端绝对不能悬空，否则不但容易接受外界噪声干扰，破坏正常的逻辑关系，

也消耗功率。因此，应该根据电路的逻辑功能需要，对输入悬空端加以处理。例如，与门和与非门的多余输入端应接到高电平或正电源，如果电路的工作速度不高，不需要特别考虑功率时，也可以将多余的输入端和使用端并联使用。

⑦ 严禁带电插拔器件，以免瞬态电压损坏 CMOS 器件。

⑧ CMOS 电路的工作电流比较小，其输出端一般只能驱动一级晶体管，如果需要驱动比较大的负载时，最简单的方法是在输出端并联接入几个非门，而且必须在同一芯片上。如图 1-3-1 所示。

图 1-3-1 反向器的并联



## 1.3.4 集成电路命名方法

### (1) 国内命名方法

器件型号由五部分组成：第一部分由字母表示国家标准；第二部分由字母表示器件的类型；第三部分由阿拉伯数字表示器件的系列和品种代号；第四部分由字母表示器件的工作温度范围；第五部分由字母表示器件的封装形式。各部分符号及其意义如表 1-3-2 所示。

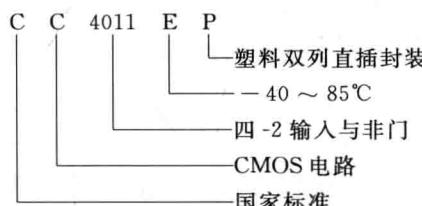
表 1-3-2 集成电路符号及其意义

第一部分		第二部分		第三部分	第四部分		第五部分	
符号	含义	符号	含义	阿拉伯数字	符号	含义	符号	含义
C	中国	T	TTL	阿拉伯数字	C	0~70℃	W	陶瓷扁平
		H	HTL		E	-40~85℃	B	塑料扁平
		E	ECL		R	-55~85℃	F	全密封扁平
		C	CMOS		M	-55~125℃	D	陶瓷直插

续表

第一部分		第二部分		第三部分	第四部分		第五部分	
符号	含义	符号	含义	阿拉伯数字	符号	含义	符号	含义
		F	线性放大器				P	塑料直插
		D	电视电路				J	黑陶瓷直插
		W	稳压器				K	金属菱形
		J	接口电路				T	金属圆形
		B	非线性电路					
		M	存储器					

例如：



## (2) 国外命名方法

### 美国德克萨斯公司

SN      XX      XX      XX      X  
①      ②      ③      ④      ⑤

其中，各部分的含义如下。

① 德克萨斯公司标准电路。

② 工作温度范围。54系列——55~125℃；74系列——0~70℃。

③ 系列。ALS——先进的低功耗肖特基系列；LS——低功耗肖特基系列；S——肖特基系列。

④ 品种代号。

⑤ 封装形式。J——陶瓷双列直插；N——塑料双列直插；T——金属扁平；W——陶瓷扁平。

### 美国摩托罗拉公司

MC      XX      XX      X  
①      ②      ③      ④

其中，各部分的含义如下。

① 摩托罗拉公司标准电路。

② 工作温度范围。4, 20, 30, 72, 74, 83——0~75℃。5, 21, 31, 43, 82, 54, 93——55~125℃。

③ 品种代号。

④ 封装形式。L——陶瓷双列直插；P——塑料双列直插；F——陶瓷扁平。

### 日本日立公司

HD       $\frac{XX}{②}$        $\frac{XX}{③}$        $\frac{XX}{④}$        $\frac{X}{⑤}$

其中，各部分的含义如下。

- ① 日立公司标准电路。
- ② 工作温度范围。74—— $-20\sim75^{\circ}\text{C}$ 。
- ③ 系列。空白——标准系列； LS——低功耗肖特基系列； S——肖特基系列。
- ④ 品种代号。
- ⑤ 封装形式。空白——玻璃-陶瓷双列直插； P——塑料双列直插。

# 第2章 数字电子技术基础实验

## 2.1 实验一 集成逻辑门电路参数的测试

### 2.1.1 实验目的

- ① 熟悉 TTL 与非门和 CMOS 与非门的引脚排列及引脚功能。
- ② 掌握 TTL 与非门和 CMOS 与非门参数的测量方法及物理意义。

### 2.1.2 实验原理

在实际应用电路中，经常用到门电路。而门电路参数会影响到整体电路工作的可靠性。

本实验选择经常用到的 TTL 与非门 74LS00 和 CMOS 与非门 CC4011。74LS00 和 CC4011 都是四 2 输入与非门，其引脚排列图如图 2-1-1 所示。

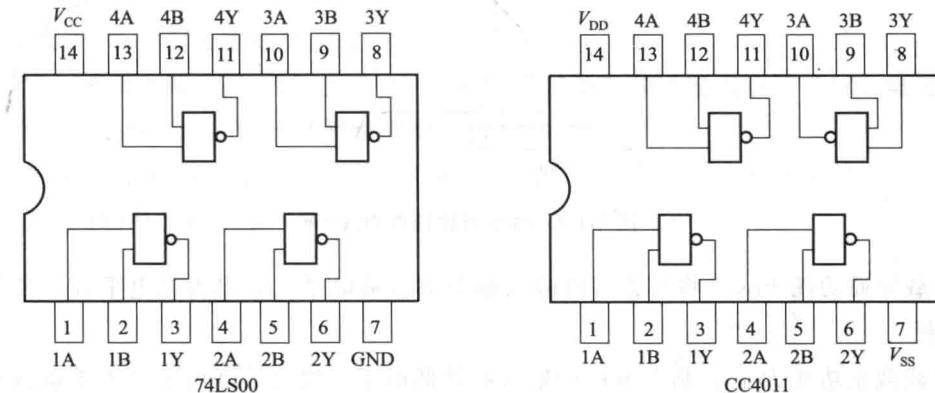


图 2-1-1 74LS00、CC4011 引脚排列

与非门的参数分为静态参数和动态参数两种。静态参数指电路处于稳定的逻辑状态下测得的参数，动态参数指逻辑状态转换过程中测得的与时间有关的参数。

TTL 与非门的主要参数如下。

- ① 输入短路电流  $I_{IS}$ 。在 TTL 与非门的输入特性曲线上，当输入电压为 0 时，此时的输入电流就称为输入短路电流。
- ② 输入漏电流  $I_{IH}$ 。在 TTL 与非门的输入特性曲线上，当输入电压上升到 1.5V 以后，

输入电流基本保持恒定值不变，称为输入高电平电流，又称为输入漏电流。

③ 输出高电平  $V_{OH}$ 。一般情况  $V_{OH} \geq 2.4V$ 。

④ 输出低电平  $V_{OL}$ 。一般情况  $V_{OL} \leq 0.4V$ 。

⑤ 扇出系数  $N_O$ 。正常工作时，一个门电路能驱动与其同类门的个数。它标志着一个门电路的带负载能力。与非门带同类负载时，最大负载电流是发生在输出低电平时，因此扇出系数的表达式为：

$$N_O = \frac{I_{OL(max)}}{I_{IS}}$$

式中， $I_{OL(max)}$  为保证输出低电平所允许的最大灌电流； $I_{IS}$  为一个负载门的输入短路电流。

⑥ 开门电平  $V_{ON}$  和关门电平  $V_{OFF}$ 。使输出电压  $V_O$  刚刚达到低电平  $V_{OL}$  时的最低输入电压称为开门电平  $V_{ON}$ 。使输出电压  $V_O$  刚刚达到高电平  $V_{OH}$  时的最高输入电压称为关门电平  $V_{OFF}$ 。

⑦ 电压传输特性曲线。输出电压随输入电压变化的关系曲线如图 2-1-2 所示。它能够充分显示与非门的逻辑关系，当输入为低电平时，输出为高电平。当输入为高电平时，输出为低电平。在曲线上可以清楚地读出  $V_{OH}$ ,  $V_{OL}$ ,  $V_{ON}$ ,  $V_{OFF}$ 。

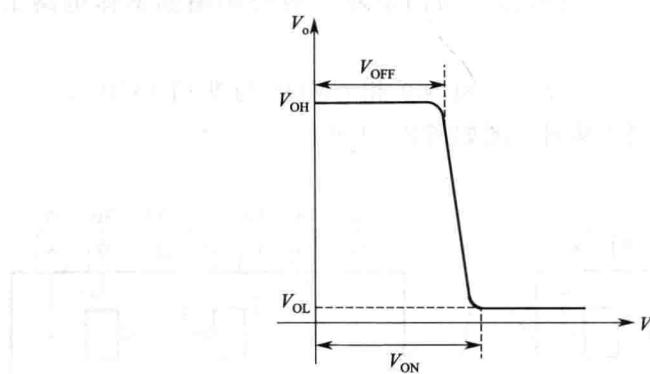


图 2-1-2 电压传输特性曲线

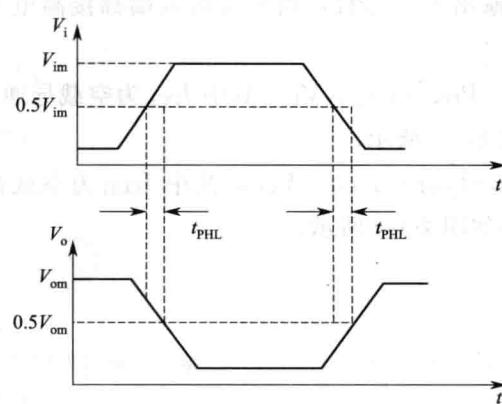
⑧ 空载导通功耗  $P_{ON}$ 。将与非门的输入端全部接高电平，输出为低电平且不带负载时的功率损耗。

⑨ 空载截止功耗  $P_{OFF}$ 。将与非门的输入端接低电平，输出为高电平且不带负载时的功率损耗。

⑩ 平均传输延迟时间  $t_{pd}$ ：传输延迟时间是 TTL 与非门的动态特性。由于晶体管内部存储电荷的积累和消散都需要时间，而且二极管、晶体管等元器件都有寄生电容存在，从而使输出电压波形总比输入电压的波形滞后一定的时间，因此造成传输延迟。如图 2-1-3 所示。

平均传输延迟时间为：

$$t_{pd} = \frac{t_{PHL} + t_{PLH}}{2}$$

图 2-1-3 平均延迟时间  $t_{pd}$ 

由于 TTL 门电路的延迟时间较小，直接测量时对函数信号发生器和示波器的性能要求比较高，因此实验中采用环形振荡器来测量  $t_{pd}$ ，即将奇数个与非门首尾相连组成图 2-1-12 所示的环形振荡器：

$$t_{pd} \approx \frac{T}{2N}$$

式中， $N$  为与非门电路的个数； $T$  为环形振荡器输出信号的振荡周期。

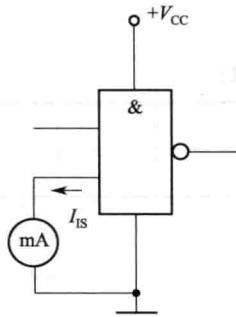
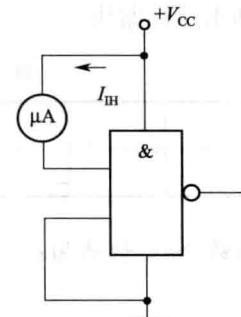
CMOS 电路参数的意义及测试方法与 TTL 电路参数的意义及测试方法基本相同，这里不再叙述。

### 2.1.3 实验内容

#### (1) TTL 与非门参数测试 (74LS00)

① 输入短路电流  $I_{IS}$ 。将与非门的一个输入端接地，其他输入端悬空时，流过该接地输入端的电流就是输入短路电流。测试方法如图 2-1-4 所示。

② 输入漏电流  $I_{IH}$ 。将与非门的一个输入端接高电平，另一个输入端接低电平时，流过高电平输入端的电流就是输入漏电流。测试方法如图 2-1-5 所示。

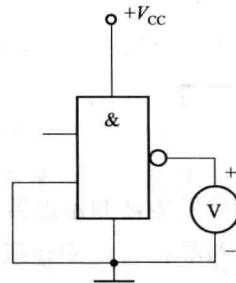
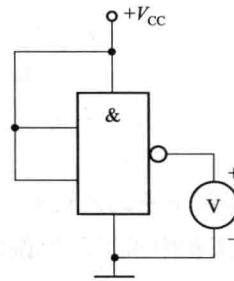
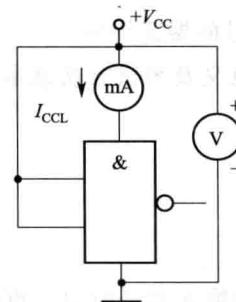
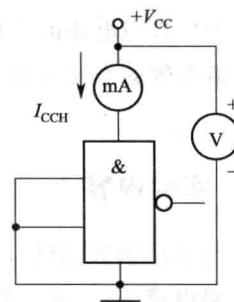
图 2-1-4 输入短路电流  $I_{IS}$  测试电路图 2-1-5 输入漏电流  $I_{IH}$  测试电路

③ 输出高电平  $V_{OH}$ 。输出不接负载，当有一输入端为低电平时电路的输出电压值。测量方法如图 2-1-6 所示。

④ 输出低电平  $V_{OL}$ 。输出不接负载，当所有输入端都接高电平时电路的输出电压值。测量方法如图 2-1-7 所示。

⑤ 空载导通功耗  $P_{ON}$ 。 $P_{ON} = I_{CCL} \times V_{CC}$ ，其中  $I_{CCL}$  为空载导通电源电流， $V_{CC}$  为电源电压 (+5V)。测试方法如图 2-1-8 所示。

⑥ 空载截止功耗  $P_{OFF}$ 。 $P_{OFF} = I_{CCH} \times V_{CC}$ ，其中  $I_{CCH}$  为空载截止电源电流， $V_{CC}$  为电源电压 (+5V)。测试方法如图 2-1-9 所示。

图 2-1-6 输出高电平  $V_{OH}$  测试方法图 2-1-7 输出低电平  $V_{OL}$  测试方法图 2-1-8 空载导通功耗  $P_{ON}$  测试方法图 2-1-9 空载截止功耗  $P_{OFF}$  测试方法

⑦ 电压传输特性。与非门输出电压随输入电压的变化曲线即为电压传输特性  $V_O = f(V_i)$ ，电压传输特性反映了与非门的逻辑关系。测试方法如图 2-1-10 所示，自拟测量数据，填入表 2-1-1，并画出特性曲线。

表 2-1-1 TTL 与非门电压传输特性

$V_1/V$									
$V_2/V$									

⑧ 扇出系数  $N_0$ 。公式为：

$$N_0 = \frac{I_{OL(max)}}{I_{IS}}$$

式中， $I_{OL(max)}$  为  $V_{OL} \leq 0.35V$  时准许灌入的最大灌入负载电流； $I_{IS}$  为输入短路电流。

扇出系数  $N_0$  的测试方法如图 2-1-11 所示。输入端悬空，接通电源，调节  $1k\Omega$  电位器，使电压表读数为  $0.35V$ ，读出此时电流的数值  $I_{OL(max)}$ ，按公式求出  $N_0$ 。

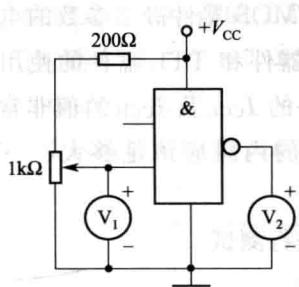
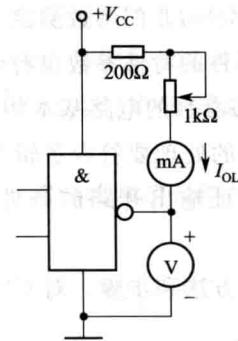
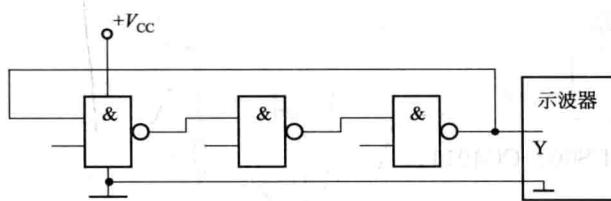


图 2-1-10 TTL 与非门电压传输特性测试电路

图 2-1-11 扇出系数 N<sub>0</sub> 测试电路图 2-1-12 用环形振荡器测量 t<sub>pd</sub>

⑨ 平均传输延迟时间  $t_{pd}$ 。这里采用 3 个与非门构成环形振荡器，如图 2-1-12 所示，输出端可接示波器或频率计来测量周期。假设每一个与非门的延迟时间都相等，3 个与非门构成的环形振荡器的周期为  $T=6t_{pd}$ ，则  $t_{pd}=\frac{T}{6}$ 。

74LS00 的主要性能参数如表 2-1-2 所示。

表 2-1-2 74LS00 主要性能参数

参数名称	符号	单位	测试条件	规范值
输出高电平	$V_{OH}$	V	$V_i=0.8V, I_{OH}=0.4mA$	$\geq 2.4$
输出低电平	$V_{OL}$	V	$V_i=2.0V, I_{OL}=4.0mA$	$\leq 0.4$
输出高电平电流	$I_{OH}$	mA	$V_i=0.8V, I_{OH}=2.7mA$	$\leq 0.4$
输出低电平电流	$I_{OL}$	mA	$V_i=2.0V, I_{OL}=0.5mA$	$\geq 8$
输入短路电流	$I_{IS}$	mA	$V_i=0V$	$\leq 0.4$
输入漏电流	$I_{IH}$	$\mu A$	$V_i=5V$	$\leq 20$
输出高电平时电源电流	$I_{CCH}$	mA		$\leq 1.6$
输出低电平时电源电流	$I_{CCL}$	mA		$\leq 4.4$
开门电平	$V_{ON}$	V		$\leq 1.8$
关门电平	$V_{OFF}$	V		$\geq 0.8$
传输延迟时间	$t_{pd}$	ns		$\leq 30$
扇出系数	$N_0$			$\geq 8$